



ФИЗИКА – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



Ф.И.О.: Гурбанов Музаффар Кадамбоевич

ДОЛЖНОСТЬ: Доцент

ТЕЛ: +99897 512 95 49

E – mail: <u>muzaffarqq@mail.ru</u>

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: г. Ургенч, ул. Х. Олимджана 14. 220100

ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ	высшее, 1999 год, УрГУ, физ-мат факультет
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:	1999 – 2001 гг – УрГУ лаборант кафедры «Физика»; 2001 – 2002 гг – УрГУ стажёр исследователь кафедры «Физика»; 2002 – 2005 гг – УрГУ аспирант кафедры «Физика»; 2005 – 2013гг – УрГУ преподаватель кафедры «Физика» 2013-по настоящее время – УрГУ доцент кафедры «Физика»;
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	Физическая электроника
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ	Электромагнетизм, радиоэлектроника
ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:	Распыление кристалла LiF при облучении моно–и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+
ПРОЕКТЫ:	 Распыление кристалла LiF при облучении моно—и полиатомными ионами Ar⁺ и SF₅⁺ Травление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF₀⁺(n=1÷5) Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF₀⁺ Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar⁺ и полиатомными SF₀⁺ Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar⁺ и полиатомными SF₀⁺ Физическое и химически-стимулированное распыление 3C-SiC при бомбардировке ионами Ar⁺ и полиатомными ионами SF₅⁺ Распыление кристалла LiF при облучении моно-и полиатомными ионами Ar⁺ и SF₀⁺ Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из LiF от энергии и скорости бомбардирующих ионов Ar⁺ и SF₀⁺ Распыление монокристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами SF₀⁺(n=1÷5) Оверхвысоковануумный вторично-ионный масс-спектрометр для изучения травления и структуры поверхности полупроводников и диэлектриков при облучении электронами, моно и полиатомными ионами Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar⁺ и полиатомными ионами SF₀⁺ Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF₀⁺(n=1÷5) Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar⁺ и полиатомными ионами SF₀⁺

- 14. Распыление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF₅⁺
- 15. Распыление поверхности кремния и карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами $SF_n^+(n=1\div 5)$
- 16. Физическое и химическое распыление карбида кремния при бомбардировке моно ${\rm Ar}^{\scriptscriptstyle +}$ и полиатомными ионами ${\rm SF_5^{\scriptscriptstyle +}}$
- 17. Анализ фторированной поверхности карбида кремния методом электронностимулированной десорбции
- 18. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами
- 19. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+
- 20. Исследование стимулированного разрывом связей молекулярного распыления и травления поверхности пленки 3C-SiC при бомбардировке моно ${\rm Ar^+}$ и полиатомными ${\rm SF_5^+}$ ионами
- 21. Кинетика точечных дефектов и их агрегатов на поверхности пленки LiF/Si(111)
- 22. Изучение отрицательно-ионных кластеров SiC при бомбардировке ионами Cs⁺
- 1. Распыления кристаллов при бомбардировке моно- и полиатомными ионам
- 2. Kinetics of aggregations F2, F3, X and colloid centers in thin film LiF/Si(111) at low temperature annealing
- 3. Исследование рассеяния ионов со ступенчатой поверхности двухкомпонентных монокристаллов
- 4. Температурный эффект атомарного и кластерного распыления SiC(100), GaN и LiF(100) при облучении ионами Cs^+ и SF_5^+
- 5. Регистрация дефектов в спектрах ВИМС при отрицательно-ионном распылении кристаллов LiF
- 6. Молекулярное распыление из кристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами $SF_n^+(n=1-5)$
- 7. Изучение массового состава положительно распыленных частиц из кристалла LiF при облучении ионами Ar^+
- 8. Отрицательно-ионное распыление Al₂O₃
- 9. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность $\mathrm{Au}(111)$ при бомбардировке ионами $\mathrm{Ar}^{\scriptscriptstyle +}$
- 10. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность Au(111) при бомбардировке ионами Ar^+
- 11. Mechanism of Aggregation Colloid Centers on Surface Ionic Crystals
- 12. Procedure for Determining Defects in Sputtered Clusters of Ionic Crystals
- 13. Изучения закономерности рассеяния ионов Ar^+ и Ne^+ с поверхности кластера кремния
- 14. Температурные зависимости распыления поверхности Si (111) при облучении ионами Cs
- 15. Влияние низкоэнергетических электронов на поверхность кристаллов оксида пинка
- 16. Электронно-спектрометрический контроль процесса очистки кремниевых пластин
- 17. Angular and energy distributions of low-energy argon ions at the scattering from A^{III}B^V semiconductor surface
- 18. Исследование малоугловое рассеяния ионов с поверхностью InP(001)
- 19. Изучение характерных траектории рассеяных ионов с поверхностью InP(001) при бомбардировке ионами Ar^+ и Ne^+
- 20. Закономерности рассеяния ионов с поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях
- 21. Рассеяния ионов с дефектной поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях
- 22. LiF кристалини якка ва кўпатомли ионлар таъсирида чанглатиш

ПУБЛИКАЦИИ